

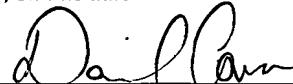


IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Ryoichi Mukai)
)
 Serial No.)
)
 Filed: January 28, 2002)
)
 For: POLYCRYSTALLINE)
 STRUCTURE FILM AND)
 METHOD OF MAKING SAME)
)
 Art Unit:)

I hereby certify that this paper is being deposited with the
 United States Postal Service as EXPRESS MAIL in an
 envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents,
 Washington, D.C. 20231, on this date.

1/28/2002
 Date


 Express Mail No. EL846223142US

CLAIM FOR PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents
 Washington, DC 20231

Sir:

Applicant claims foreign priority benefits under 35 U.S.C. § 119 on the
 basis of the foreign application identified below:

Japanese Patent Application No. 2001-233159, filed August 1, 2001

A certified copy of the priority document is enclosed.

Respectfully submitted,

GREER, BURNS & CRAIN, LTD.



By

Patrick G. Burns
 Registration No. 29,367

January 28, 2002

300 South Wacker Drive
 Suite 2500
 Chicago, Illinois 60606
 Telephone: 312.360.0080
 Facsimile: 312.360.9315

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

2500.66134
312.360.0080

24
4-19-02

1000 U.S. PRO
10/058662
01/28/02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2001年 8月 1日

出願番号
Application Number:

特願2001-233159

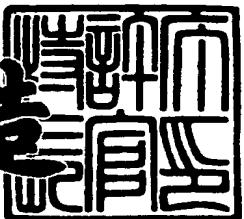
出願人
Applicant(s):

富士通株式会社

2001年12月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3109186

【書類名】 特許願
 【整理番号】 0151325
 【提出日】 平成13年 8月 1日
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 G11B 5/66
 G11B 5/708
 G11B 5/714
 【発明の名称】 多結晶構造膜およびその製造方法
 【請求項の数】 10
 【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通
 株式会社内
 【氏名】 向井 良一
 【特許出願人】
 【識別番号】 000005223
 【氏名又は名称】 富士通株式会社
 【代理人】
 【識別番号】 100105094
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 山▲崎▼ 薫
 【電話番号】 03-5226-0508
 【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 049618
 【納付金額】 21,000円
 【提出物件の目録】
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9803088

特2001-233159

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多結晶構造膜およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 化合物を含み、基板の表面に散在する金属粒子核と、基板の表面を覆い、金属粒子核を包み込んで成長した結晶粒を含む金属結晶層とを備えることを特徴とする多結晶構造膜。

【請求項2】 請求項1に記載の多結晶構造膜において、前記化合物は金属化合物であることを特徴とする多結晶構造膜。

【請求項3】 請求項1および2に記載の多結晶構造膜において、前記金属粒子核は白金を含むことを特徴とする多結晶構造膜。

【請求項4】 基板の表面に金属元素および化合物を降り注がせる工程を備えることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【請求項5】 請求項4に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素および化合物を降り注がせるにあたって高周波スパッタリング法が用いられるることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【請求項6】 請求項5に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記高周波スパッタリング法のターゲットは、前記金属元素の粉体と前記化合物の粉体との混合物であることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【請求項7】 請求項5に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記高周波スパッタリング法のターゲットは、前記金属元素の塊と、塊の表面に配置される前記化合物の小片とを備えることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【請求項8】 請求項4に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素および化合物を降り注がせるにあたって、前記金属元素をターゲットとした直流スパッタリング法と、前記化合物をターゲットとした高周波スパッタリング法とが同時に行われることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【請求項9】 請求項4～8のいずれかに記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素および化合物を降り注がせるにあたって、前記基板は常温に維持されることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【請求項10】 請求項9に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記

金属元素および化合物の堆積後に前記基板上で結晶粒を成長させるにあたって、前記基板は常温に維持されることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えばハードディスク（HD）といった磁気記録媒体に使用することができる多結晶構造膜に関し、特に、基板の表面に散在する粒子核と、こういった粒子核を包み込んで成長した結晶粒を含む結晶層とを備える多結晶構造膜およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

磁気記録媒体の技術分野では磁性体の多結晶構造膜は広く利用される。こういった多結晶構造膜は、一般に、ディスク基板の表裏面に形成されるCr層すなわち下地結晶層と、このCr層からエピタキシャル成長するCo合金層すなわち磁性結晶層とを備える。広く知られるように、Co合金層の磁性粒が微小化されれば、磁気情報の読み出しにあたってノイズは一層低減されることができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

Cr層上でCo合金層をエピタキシャル成長させる場合、Cr層内で結晶粒の微小化が達成されない限りCo合金層内の磁性粒の微小化は実現されることはできない。これまでのところ、Cr層内で十分に結晶粒を微小化する術は確立されていない。

【0004】

本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、金属結晶層内で結晶粒の微小化に大いに貢献することができる多結晶構造膜およびその製造方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明によれば、基板の表面に金属元素および化

合物を降り注がせる工程を備えることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法が提供される。

【0006】

こうして金属元素と化合物とが基板上に同時に降り注ぐと、基板の表面には微細な金属粒子核が高密度に形成されることができる。こうした粒子核の形成後に金属原子が堆積していくと、金属原子は微小な結晶粒に成長していくことができる。

【0007】

化合物には例えば金属化合物が用いられればよい。こういった金属化合物には、例えば SiO_2 や Al_2O_3 といった金属酸化物のほか、例えば Si_3N_4 といった金属窒化物が含まれることができる。金属元素は例えば白金を含めればよい。

【0008】

こういった粒子核の形成にあたっては例えば高周波スパッタリング法が用いられればよい。このとき、ターゲットには、金属元素の粉体と化合物の粉体との混合物が用いられればよい。高周波スパッタリング法は、基板上に絶縁性の金属酸化物や金属窒化物を降り注がせることができる。

【0009】

その他、いわゆる金属元素の塊がターゲットに用いられてもよい。この場合には、塊の表面に化合物の小片が配置されればよい。こういったターゲットによれば、塊の露出面積と小片の露出面積とに基づき、金属粒子核に含まれる化合物の含有量は比較的に簡単に調整されることができる。

【0010】

粒子核の形成にあたってはいわゆるコウ・スパッタリング法が用いられてもよい。このコウ・スパッタリング法では、導電性の金属元素に直流電源が接続されればよく、絶縁性の化合物に高周波電源が接続されればよい。こういったコウ・スパッタリング法によれば、直流電源の出力の大きさに基づき金属元素の堆積量は簡単に調整されることができ、同時に、高周波電源の出力の大きさに基づき化合物の堆積量は調整されることができる。したがって、金属粒子核に含まれる化

合物の含有量は非常に簡単に調整することができる。

【0011】

以上のような製造方法によれば、例えば、化合物を含み、基板の表面に散在する金属粒子核と、基板の表面を覆い、金属粒子核を包み込んで成長した結晶粒を含む金属結晶層とを備える多結晶構造膜は提供することができる。

【0012】

こういった多結晶構造膜では、前述のように、金属粒子核の働きで微小な結晶粒は確立することができる。例えばこういった多結晶構造膜が磁気記録媒体に利用されると、記録トラックの高密度化すなわち磁気記録媒体の大容量化は実現することができる。記録トラック同士の間で遷移ノイズは極力低減されることができる。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。

【0014】

図1は磁気記録媒体駆動装置の一具体例すなわちハードディスク駆動装置(HDD)11の内部構造を概略的に示す。このHDD11は、例えば平たい直方体の内部空間を区画する箱形の筐体本体12を備える。収容空間には、磁気記録媒体としての1枚以上の磁気ディスク13が収容される。磁気ディスク13はスピンドルモータ14の回転軸に装着される。スピンドルモータ14は、例えば72000 rpmや10000 rpmといった高速度で磁気ディスク13を回転させることができる。筐体本体12には、筐体本体12との間で収容空間を密閉する蓋体すなわちカバー(図示せず)が結合される。

【0015】

収容空間には、垂直方向に延びる支軸15回りで揺動するキャリッジ16がさらに収容される。このキャリッジ16は、支軸15から水平方向に延びる剛体の揺動アーム17と、この揺動アーム17の先端に取り付けられて揺動アーム17から前方に延びる弾性サスペンション18とを備える。周知の通り、弾性サスペンション18の先端では、いわゆるジンバルばね(図示せず)の働きで浮上ヘッ

ドライダ19は片持ち支持される。浮上ヘッドドライダ19には、磁気ディスク13の表面に向かって弾性サスペンション18から押し付け力が作用する。磁気ディスク13の回転に基づき磁気ディスク13の表面で生成される気流の働きで浮上ヘッドドライダ19には浮力が作用する。弾性サスペンション18の押し付け力と浮力とのバランスで磁気ディスク13の回転中に比較的に高い剛性で浮上ヘッドドライダ19は浮上し続けることができる。

【0016】

こうした浮上ヘッドドライダ19の浮上中に、キャリッジ16が支軸15回りで揺動すると、浮上ヘッドドライダ19は半径方向に磁気ディスク13の表面を横切ることができる。こうした移動に基づき浮上ヘッドドライダ19は磁気ディスク13上の所望の記録トラックに位置決めされる。このとき、キャリッジ16の揺動は例えばボイスコイルモータ（VCM）といったアクチュエータ20の働きを通じて実現されればよい。周知の通り、複数枚の磁気ディスク13が筐体本体12内に組み込まれる場合には、隣接する磁気ディスク13同士の間で1本の揺動アーム17に対して2つの弾性サスペンション18が搭載される。

【0017】

図2は磁気ディスク13の断面構造を詳細に示す。この磁気ディスク13は、支持体としての基板21と、この基板21の表裏面に広がる多結晶構造膜22とを備える。基板21は、例えば、ディスク形のSi本体23と、Si本体23の表裏面に広がる非晶質のSiO₂膜24とで構成されればよい。ただし、基板21にはガラス基板やアルミニウム基板が用いられてもよい。多結晶構造膜22に磁気情報は記録される。多結晶構造膜22の表面は炭素保護膜25や潤滑膜26で被覆される。

【0018】

多結晶構造膜22は、基板21の表面に散在する多数の島状金属粒子核（nucleation site）27を備える。こういった金属粒子核27は、例えばCo₈₈Pt₁₂合金といった金属元素と、例えばSiO₂といった金属化合物とで構成されればよい。金属化合物は例えば5～20at%の割合で金属粒子核27に含まれればよい。その他、金属化合物は、例えばAl₂O₃といった金属

酸化物や、例えば Si_3N_4 といった金属窒化物であってもよい。こういった金属粒子核 27 の形成方法は後ほど詳述される。

【0019】

基板 21 の表面には、金属粒子核 27 を包み込む下地結晶層 28 が広がる。下地結晶層 28 では金属粒子核 27 ごとに微細な結晶粒 29 が区画される。この下地結晶層 28 は例えば Cr 層で構成されればよい。下地結晶層 28 の表面には、下地結晶層 28 と同一の格子構造を備える磁性結晶層 30 が広がる。下地結晶層 28 と磁性結晶層 30 との間にはエピタキシャル成長が確立される。この磁性結晶層 30 には、例えば粒界 31 に沿って拡散する非磁性原子すなわち Cr 原子が含まれる。こういった磁性結晶層 30 は例えば $\text{Co}_{90}\text{Pt}_{10}$ といった Co 合金から構成されればよい。

【0020】

こういった多結晶構造膜 22 では、後述されるように、下地結晶層 28 および磁性結晶層 30 で非常に微細な結晶粒 29 が実現されることができる。したがって、磁気ディスク 13 の表面で規定される記録トラック同士の間で遷移ノイズは極力低減されることができる。こうして微小化された結晶粒 29 すなわち磁性粒子は記録トラックの高密度化すなわち磁気ディスク 13 の大容量化に大いに貢献することができる。

【0021】

次に磁気ディスク 13 の製造方法を詳述する。まず、図 3 に示されるように、ディスク形の基板 21 は用意される。基板 21 はスパッタリング装置に装着される。スパッタリング装置内には真空環境が確立される。基板 21 には例えば 350°C 程度で 2 分間の加熱が施される。こうして基板 21 の表面から自然吸着ガスは取り除かれる。その後、基板 21 は常温（いわゆる室温）まで冷却される。

【0022】

スパッタリング装置では、図 4 に示されるように、真空環境下で基板 21 の表面に例えば Co 原子 31 や Pt 原子 32、 SiO_2 分子 33 が降り注がれる。 SiO_2 分子 33 は、Co 原子 31 および Pt 原子 32 の総量に対して例えば 5~20 at % の割合で降り注がれればよい。

【0023】

こうして降り注がれたC o 原子3 1、P t 原子3 2およびS i O₂ 分子3 3は、図5に示されるように、基板2 1の表面に散在する微細な金属粒子核2 7を形成する。このとき、基板2 1はスパッタリング装置内で常温に維持される。その結果、金属粒子核2 7の成長は抑制される。単位面積当たりの金属粒子核2 7の密度は著しく高められる。その一方で、こういった微細な金属粒子核2 7が高温に曝されると、熱凝集に基づき粒子核の成長は促進されてしまう。各粒子核は肥大化すると同時に、粒子核同士の間隔は広がる。

【0024】

ここで、金属粒子核2 7の散在にあたって用いられる高周波スパッタリング装置を詳述する。図6に示されるように、スパッタリング装置3 5は、気密に保持されるチャンバ3 6と、R F (高周波) 電源3 7に接続される陰極3 8および陽極3 9とを備える。チャンバ3 6内は例えば 1.33×10^{-7} [Pa] に減圧される。この減圧にあたっては例えば真空ポンプ(図示せず)が用いられればよい。こうした真空排気後にチャンバ3 6内には例えばアルゴンガスが導入される。その後、チャンバ3 6内は例えば 4.0×10^{-1} [Pa] の圧力下に保持される。

【0025】

陰極3 8上にはターゲット3 9が配置される。ターゲット3 9は例えばC o P t 合金粉体とS i O₂ 粉体とで構成されればよい。粉体は例えば加圧下で固められる。ターゲット3 9には、例えば5~20 at %の割合でS i O₂ 粉体が混合されればよい。陽極4 1上には基板2 1が配置される。

【0026】

R F 電源3 7から例えば300Wの電力が output されると、陰極3 8および陽極3 9に高周波グロー放電は引き起こされる。高周波グロー放電はアルゴンプラズマを生成する。アルゴンプラズマは陰極3 8近傍の電位降下に基づき加速する。こうしてターゲット3 9の表面にはアルゴンプラズマが衝突する。こういったR F 電源3 7を用いたスパッタリング装置3 5では、絶縁性のターゲット3 9で帶電は回避することができる。したがって、金属酸化物や金属窒化物といった絶

縁体は確実に基板21の表面に降り注がれることができる。

【0027】

高周波グロー放電が開始されると、前述のように、ターゲット39の表面からCo原子31、Pt原子32およびSiO₂分子33とが弾き出される。これらの原子30、32や分子33は陽極41上の基板21に降り注ぐ。降り注がれたCo原子31、Pt原子32およびSiO₂分子33は基板21の表面に微細な島状金属粒子核27を形成する。例えばターゲット39でSiO₂の含有率が5at%を下回ると、島状構造の形成は実現されることはできない。ターゲット39でSiO₂の含有率が20at%を上回ると、島状構造の形成は確立されるものの、粒子核27はSiO₂に埋没してしまう。こういった粒子核27は結晶粒の成長に寄与することができない。金属粒子核27に含まれる原子30、32や分子33の比率(at%)はターゲット39のそれを反映する。

【0028】

例えば図7に示されるように、ターゲット42には、円盤状に加工されたCo-Pt合金の塊43が用いられてもよい。この塊43の表面にはSiO₂の小片44が配置される。こういったターゲット42によれば、塊43の露出面と小片44の露出面との面積比に基づき金属粒子核27の成分構成比は決定されることができる。その他、図8に示されるように、ターゲット45では、CoPt合金領域46とSiO₂領域47とが隣接して配置されてもよい。

【0029】

金属粒子核27の形成にあたってはいわゆるコウ・スパッタリング装置が用いられてもよい。図9に示されるように、コウ・スパッタリング装置48はチャンバ36内に2つの陰極49、50および陽極51を備える。陰極49はDC(直流)電源52に接続され陰極50はRF電源53に接続される。陰極49には例えば導電性のCoPt合金ターゲット54が配置される。陰極50には例えば絶縁性のSiO₂ターゲット55が配置される。

【0030】

こういったコウ・スパッタリング装置48では、陰極49と陽極51との間で直流グロー放電が引き起こされると同時に、陰極50と陽極51との間で高周波

グロー放電が引き起こされる。直流グロー放電に基づき基板21の表面にはC o原子やP t原子が降り注ぐ。同時に、高周波グロー放電は基板21の表面にS iO₂分子を降り注がせる。こうして基板21の表面には微細な金属粒子核27は形成される。

【0031】

こういったコウ・スパッタリング装置48では、DC電源52の出力の大きさに応じてC o原子やP t原子の堆積量は決定されることができる。同時に、RF電源53の出力の大きさに応じてS iO₂分子の堆積量は決定されることができる。したがって、DC電源52やRF電源53の出力が調整されれば、各ターゲット54、55の大きさや表面積に拘わらず、金属粒子核27の構成成分比は任意に調節されることができる。異なる構成成分比ごとに複数個のターゲットが作成される必要はない。例えば95:5のat%比でC o P t合金およびS iO₂金属化合物が降り注がれる場合には、DC電源52の出力は100W程度に設定されればよく、同時に、RF電源53の出力は50W程度に設定されればよい。このとき、堆積時間は例えば1秒に設定されればよい。

【0032】

金属粒子核27の形成後、図10に示されるように、基板21の表面に向けてCr原子が降り注がれる。基板21の表面にはCr原子が堆積していく。こうしたCr原子の堆積には、例えば前述と同様にスパッタリング法が用いられればよい。こうして基板21の表面にCr原子が堆積すると、Cr原子は個々の金属粒子核27を中心に微細な結晶粒29を形成する。こうして基板21の表面には例えば膜厚18.0nm程度の下地結晶層28すなわちCr層が形成される。

【0033】

こうしてCr原子が堆積する間、基板21は常温に維持され続ける。したがって、Cr原子の堆積時に金属粒子核27の熱凝集は確実に回避されることができる。大きな粒子核の形成は阻止される。結晶粒29は極めて微細に形成されることができる。

【0034】

図11に示されるように、下地結晶層53の表面には磁性結晶層30すなわち

例えば膜厚7.8 nm程度のCo₉₀Pt₁₀層が積層される。こういった磁性結晶層30の積層には、例えば前述と同様にスパッタリング法が用いられればよい。Co原子やPt原子は真空中でCr層の表面に堆積していく。Co原子やPt原子はエピタキシャル成長に基づき微細な結晶粒すなわち磁性粒に成長する。こういったエピタキシャル成長に基づきCo₉₀Pt₁₀層内には粒界が確立される。

【0035】

この後、粒界56に沿って下地結晶層28すなわちCr層内のCr原子が拡散されてもよい。こういったCr原子の偏析は粒界56に沿って非磁性材の壁を作り出す。こうして多結晶構造膜22は形成される。多結晶構造膜22の表面には例えば膜厚5.0 nm程度の炭素保護膜25と例えば膜厚1.0 nm程度の潤滑膜26とが積層される。

【0036】

本発明者は、以上のように製造された多結晶構造膜22を検証した。この検証ではスパッタリング法の実施にあたって前述のRF電源37が用いられた。ターゲット39では、95対5の割合(at%)でCo₈₈Pt₁₂合金粉体とSiO₂粉体とは混合された。スパッタリング装置35では、Co原子やPt原子、SiO₂分子の堆積量は膜厚換算で0.4 nmに設定された。

【0037】

検証にあたって発明者は比較例を用意した。この比較例では、大気中に放置された後に基板はスパッタリング装置に装着された。真空環境下で基板の表面にはCo原子やPt原子が降り注がれた。スパッタリング装置では、Co原子やPt原子の堆積量は膜厚換算で1.0 nm程度に設定された。CoPt合金の堆積後、基板は高温に曝された。こうして基板の表面には、熱凝集に基づき粒子核は形成された。

【0038】

こうして得られた基板の表面上で粒子核の粒径分布は測定された。この測定にあたって基板の透過型電子顕微鏡(TEM)像が用いられた。TEM像上で粒子核の粒径および個数は観察された。図12に示されるように、本実施形態に係る粒子核では平均粒径6.8 nmが得られた。対数正規分布に基づき分散値1.2

$n m$ が算出された。平均粒径に対する分散値の比率0.18が得られた。その一方で、図13に示されるように、熱凝集に基づく粒子核では平均粒径12.7 $n m$ および分散値2.6 $n m$ が得られた。平均粒径に対する分散値の比率0.20は得られた。本実施形態に基づけば、分散値の比率は著しく改善された。結晶粒29は著しく微細化されることが確認された。

【0039】

(付記1) 化合物を含み、基板の表面に散在する金属粒子核と、基板の表面を覆い、金属粒子核を包み込んで成長した結晶粒を含む金属結晶層とを備えることを特徴とする多結晶構造膜。

【0040】

(付記2) 付記1に記載の多結晶構造膜において、前記化合物は金属化合物であることを特徴とする多結晶構造膜。

【0041】

(付記3) 付記2に記載の多結晶構造膜において、前記金属化合物は金属窒化物および金属酸化物のうち少なくともいずれか1つを含むことを特徴とする多結晶構造膜。

【0042】

(付記4) 付記3に記載の多結晶構造膜において、前記金属化合物は Si_3N_4 、 SiO_2 および Al_2O_3 のいずれかであることを特徴とする多結晶構造膜。

【0043】

(付記5) 付記1～4のいずれかに記載の多結晶構造膜において、前記金属粒子核は白金を含むことを特徴とする多結晶構造膜。

【0044】

(付記6) 付記1～6のいずれかに記載の多結晶構造膜において、前記化合物は5～20at%で金属粒子核に含まれることを特徴とする多結晶構造膜。

【0045】

(付記7) 基板の表面に金属元素および化合物を降り注がせる工程を備えることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0046】

(付記8) 付記7に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素および化合物を降り注がせるにあたって高周波スパッタリング法が用いられることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0047】

(付記9) 付記8に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記高周波スパッタリング法のターゲットは、前記金属元素の粉体と前記化合物の粉体との混合物であることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0048】

(付記10) 付記8に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記高周波スパッタリング法のターゲットは、前記金属元素の塊と、塊の表面に配置される前記化合物の小片とを備えることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0049】

(付記11) 付記7に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素および化合物を降り注がせるにあたって、前記金属元素をターゲットとした直流スパッタリング法と、前記化合物をターゲットとした高周波スパッタリング法とが同時にに行われることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0050】

(付記12) 付記7～11のいずれかに記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素および化合物を降り注がせるにあたって、前記基板は常温に維持されることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0051】

(付記13) 付記12に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素および化合物の堆積後に前記基板上で結晶粒を成長させるにあたって、前記基板は常温に維持されることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0052】

(付記14) 付記7～13のいずれかに記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記化合物は金属化合物であることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0053】

(付記15) 付記14に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属化合物は金属窒化物および金属酸化物のうち少なくともいずれか1つを含むことを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0054】

(付記16) 付記15に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属化合物は Si_3N_4 、 SiO_2 および Al_2O_3 のいずれかであることを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0055】

(付記17) 付記7~13に記載の多結晶構造膜の製造方法において、前記金属元素は白金を含むことを特徴とする多結晶構造膜の製造方法。

【0056】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、金属結晶層で結晶粒は確実に微小化されることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 磁気記録媒体駆動装置の一具体例すなわちハードディスク駆動装置(HDD)の内部構造を概略的に示す平面図である。

【図2】 本発明の一実施形態に係る磁気ディスクの構造を詳細に示す拡大断面図である。

【図3】 磁気ディスクの製造工程を概略的に示す基板の断面図である。

【図4】 粒子核の形成過程を概念的に示す基板の断面図である。

【図5】 粒子核の形成過程を概念的に示す基板の断面図である。

【図6】 高周波スパッタリング装置を概略的に示す平面図である。

【図7】 ターゲットの一具体例を示す斜視図である。

【図8】 ターゲットの一具体例を示す斜視図である。

【図9】 コウ・スパッタリング装置を概略的に示す平面図である。

【図10】 結晶粒の形成過程を概念的に示す基板の断面図である。

【図11】 結晶粒の形成過程を概念的に示す基板の断面図である。

【図12】 本実施形態に係る粒子核の粒径分布を示すグラフである。

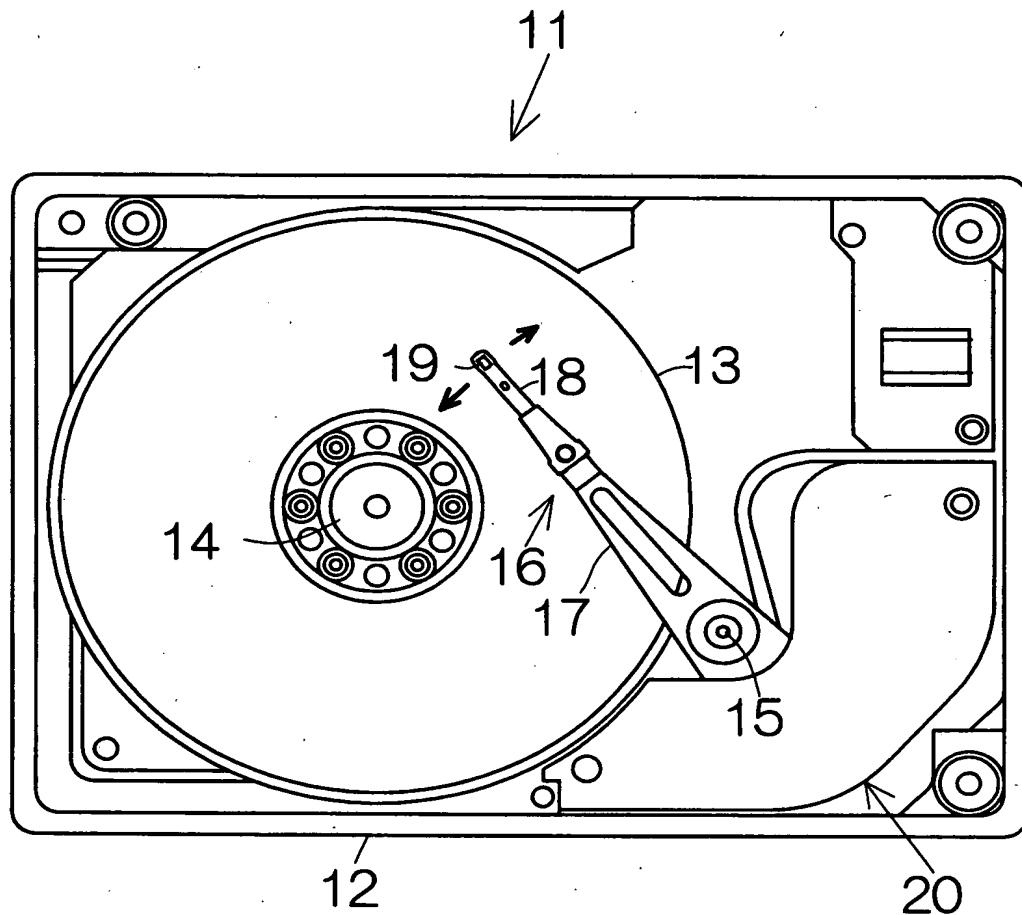
【図13】 熱凝集に基づき形成された粒子核の粒径分布を示すグラフである。

【符号の説明】

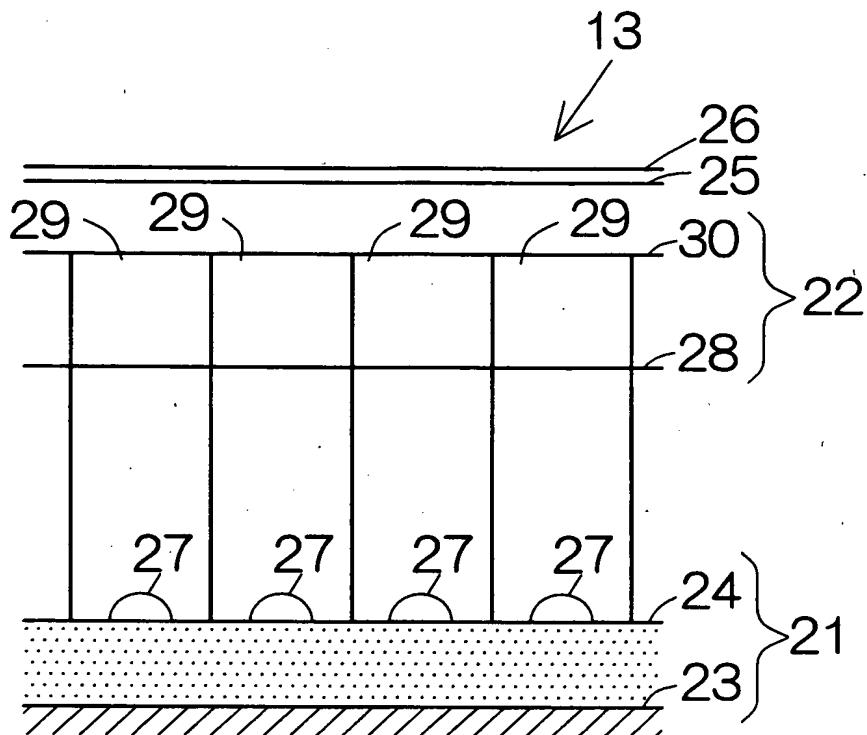
13 磁気ディスク、21 基板、22 多結晶構造膜、27 金属粒子核、
28 下地結晶層、29 結晶粒、30 磁性結晶層、31 金属元素としての
Co、32 金属元素としてのPt、33 化合物（金属化合物）としてのSi
 O_2 、35 スパッタリング装置、39 ターゲット、42 ターゲット、45
ターゲット、48 コウ・スパッタリング装置、54 ターゲット、55 ター
ゲット。

【書類名】 図面

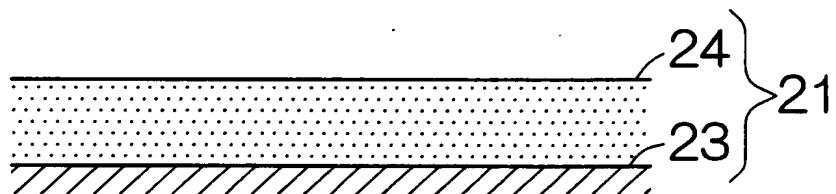
【図1】



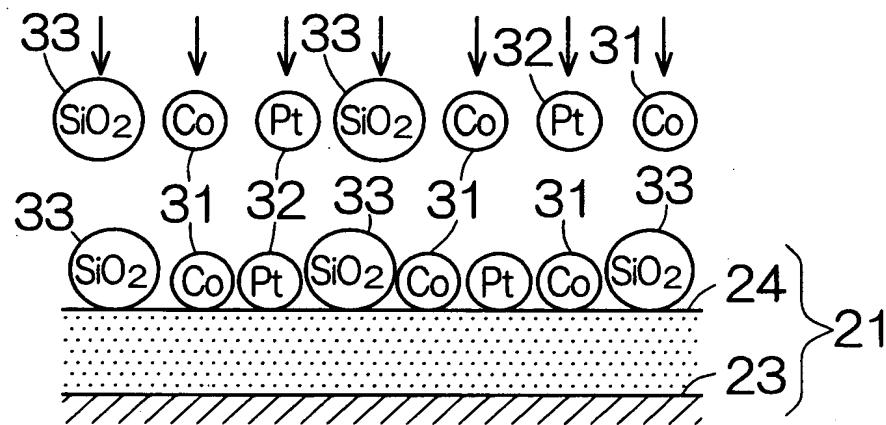
【図2】



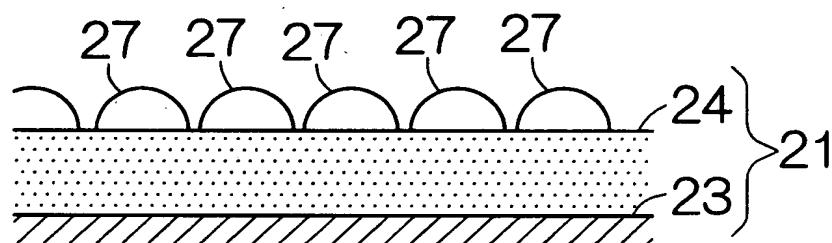
【図3】



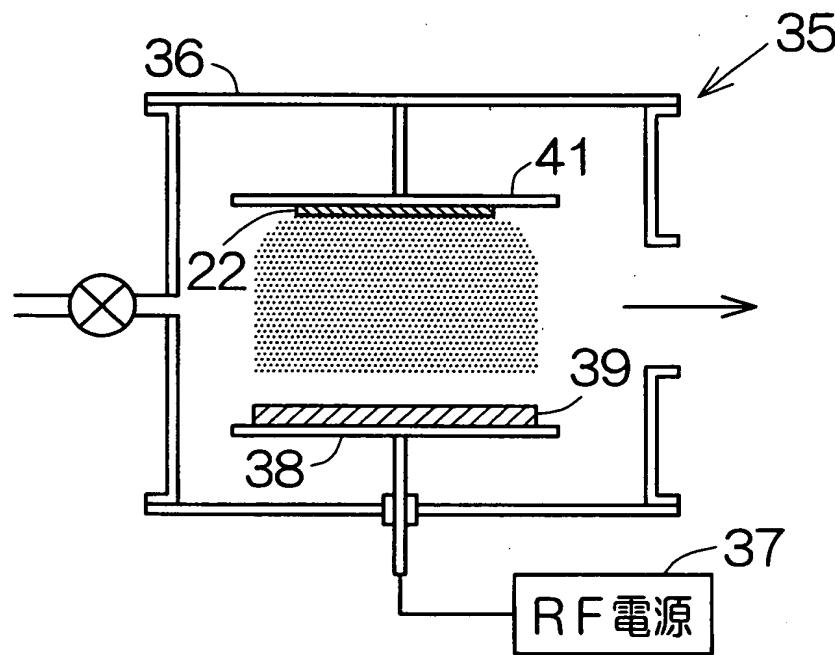
【図4】



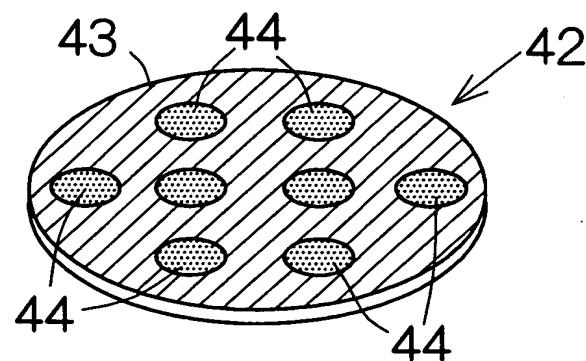
【図5】



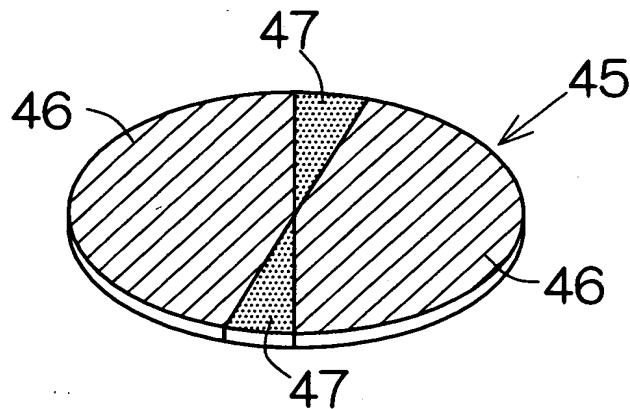
【図6】



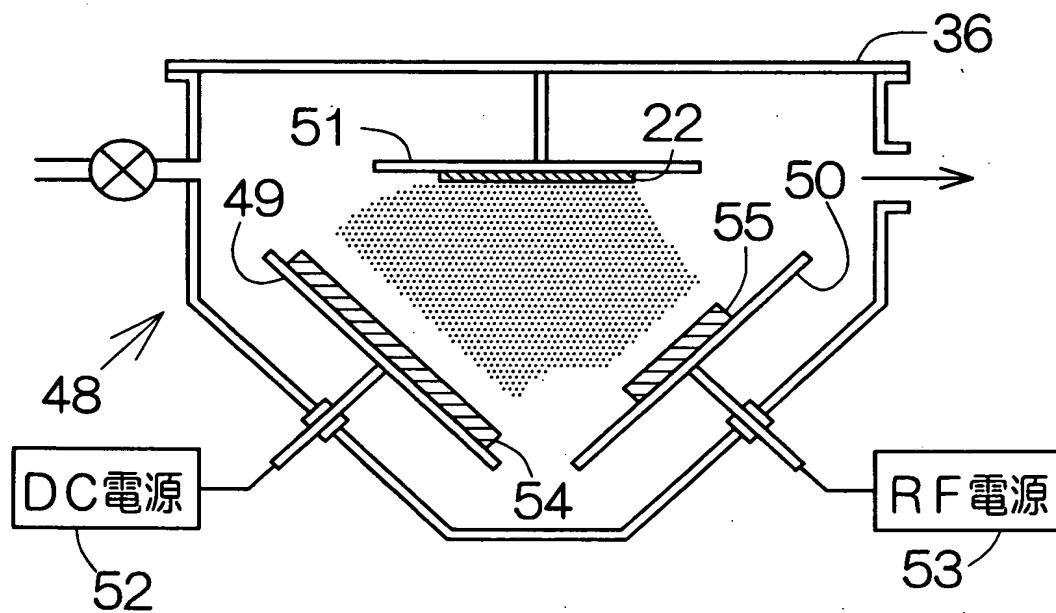
【図7】



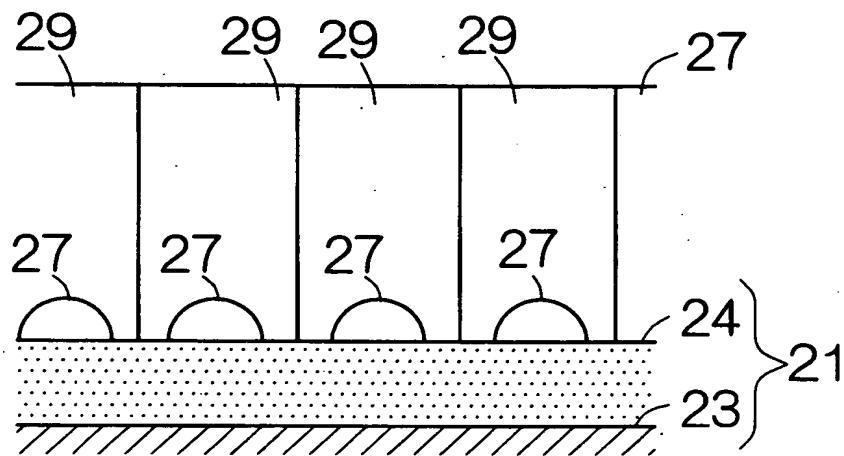
【図8】



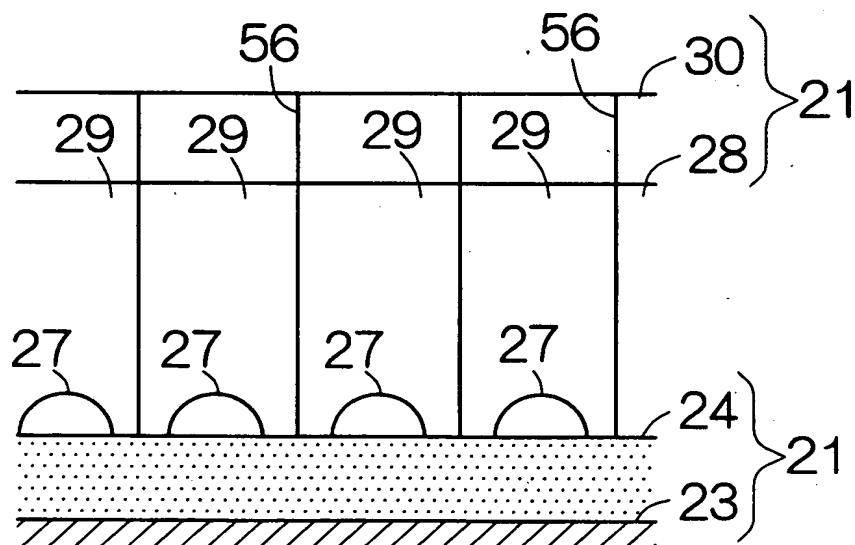
【図9】



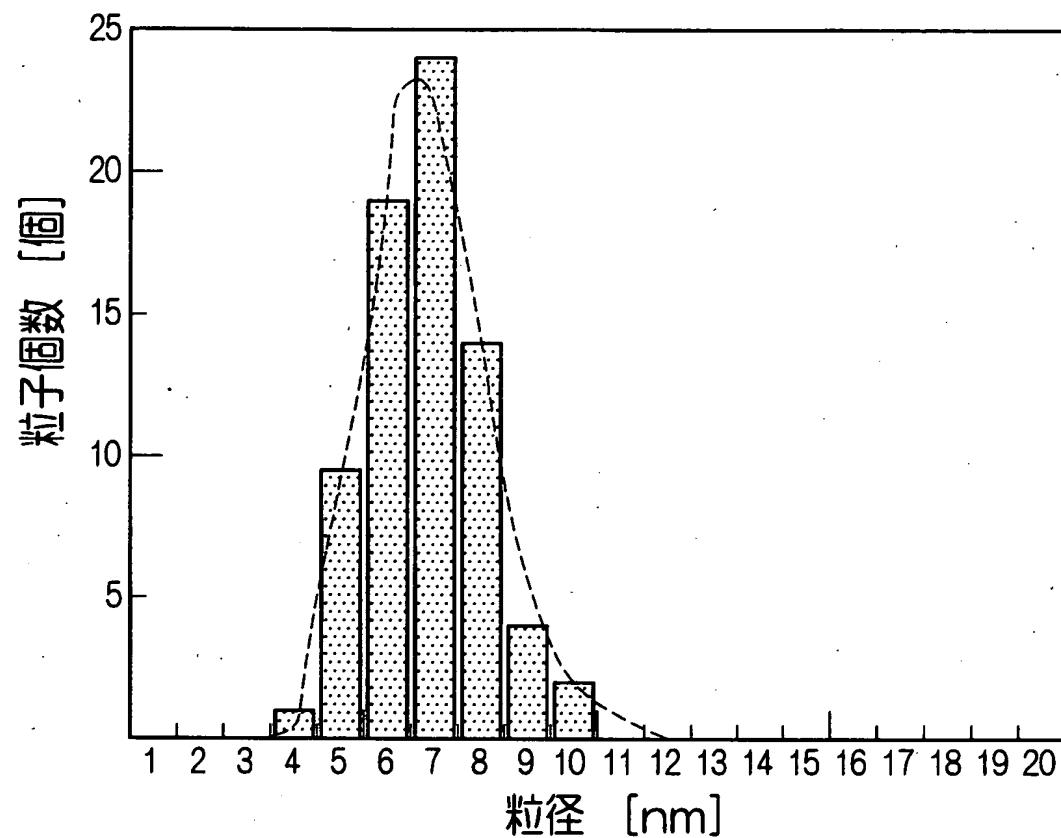
【図10】



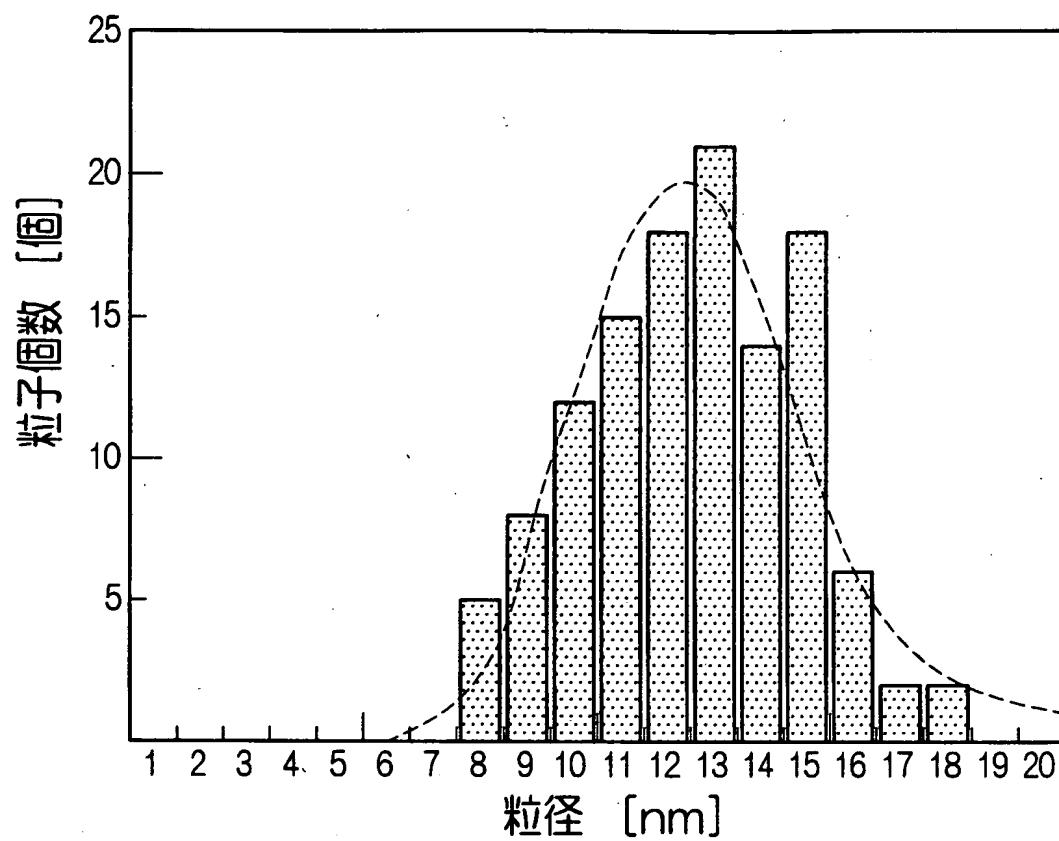
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 結晶層内に形成される磁性粒の微小化に大いに貢献することができる多結晶構造膜、およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 スパッタリング装置に装着された基板21の表面には、C_o原子31、P_t原子32およびSiO₂分子33が降り注がれる。このとき、基板21はスパッタリング装置内で常温に維持される。基板21上に降り注がれたC_o原子31、P_t原子32およびSiO₂分子33は、基板21の表面で散在する微細な金属粒子核を形成する。単位面積当たりの金属粒子核の密度は著しく高められる。

【選択図】 図4

出願人履歴情報

識別番号 [000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
氏 名 富士通株式会社